

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

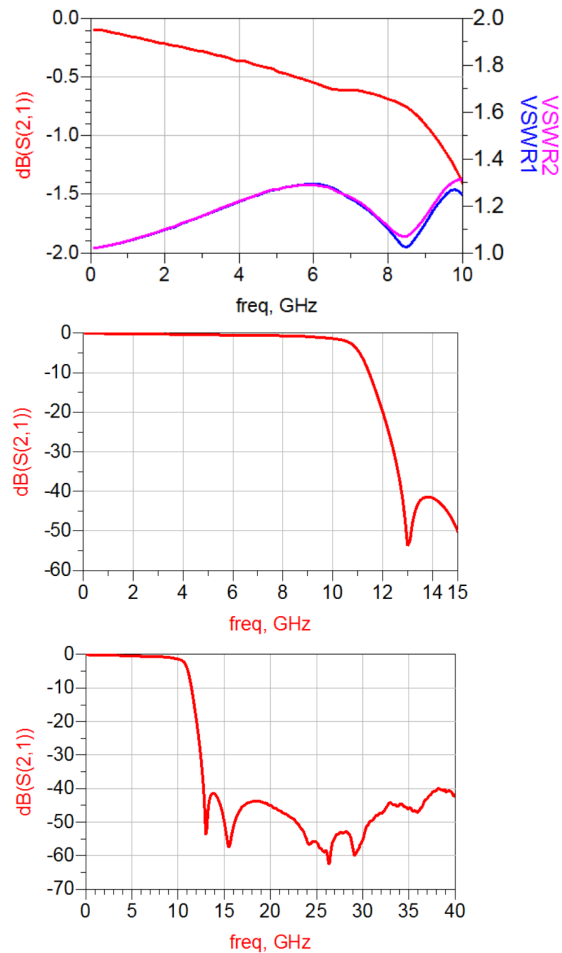
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	10000	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带外抑制	12800	MHz $\geq$	30			dBc
带外抑制	13100	MHz $\geq$	40			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

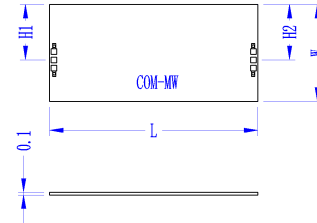
典型测试曲线图



参考实物图

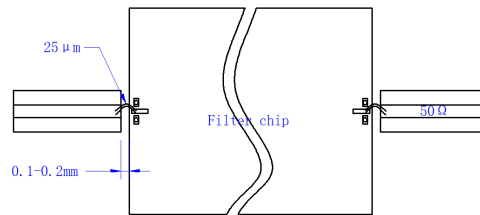


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.45	1.5	1.55
W	0.75	0.8	0.85
H1		0.4	
H2		0.4	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。